



# 中华人民共和国国家标准

GB/T 30866—2014

---

## 碳化硅单晶片直径测试方法

Test method for measuring diameter of monocrystalline silicon carbide wafers

2014-07-24 发布

2015-02-01 实施

---

中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局  
中国国家标准化管理委员会 发布

## 前 言

本标准按照 GB/T 1.1—2009 给出的规则起草。

本标准由全国半导体设备和材料标准化技术委员会(SAC/TC 203)及材料分技术委员会(SAC/TC 203/SC 2)共同提出并归口。

本标准起草单位:中国电子科技集团公司第四十六研究所、中国电子技术标准化研究院。

本标准主要起草人:丁丽、周智慧、蔺娴、郝建民、何秀坤、刘筠、冯亚彬、裴会川。

## 碳化硅单晶片直径测试方法

### 1 范围

本标准规定了用千分尺测量碳化硅单晶片直径的方法。

本标准适用于碳化硅单晶片直径的测量。

### 2 方法提要

避开碳化硅单晶片主副参考面,选取三个测量位置(如图 1 所示),沿直径方向用外径千分尺测量碳化硅单晶片的三条直径,计算直径平均值和直径偏差。

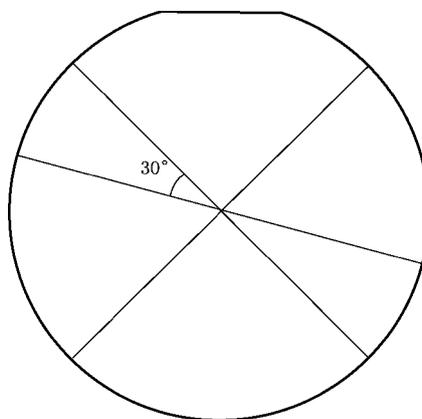


图 1 直径测量位置示意图

### 3 仪器设备

分度值为 0.02 mm 的外径千分尺或精度相当的其他仪器。

### 4 试样准备

碳化硅单晶片应清洁、干燥,边缘应光滑、平整。

### 5 测试环境

5.1 温度:18 ℃~28 ℃。

5.2 相对湿度应不大于 75%。

### 6 测试程序

6.1 校正外径千分尺零点。